

王其民 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

赵丽伟 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

藤晓云 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

张唯 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

刘彩池 天津 河北工业大学信息功能材料研究所 300130

摘要: 本文采用原子力显微镜 (AFM) 对Si 基外延GaN的形貌及出现的V缺陷进行研究。实验结果表明, GaN外延层厚度为0.5 μm 时粗糙度最低且没有裂纹出现;厚度为0.4 μm 的GaN表面出现小坑——V缺陷,密度约为10 8 cm^{-2} 。

关键词:

FONT face=Verdana>机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器, 请先下载PDF阅读器 Acrobat文章全文为PDF格式, 请下载至本Reader [[下载阅读器](#)]

The application of atomic force microscopy in the investigation of GaN

300130

300130

300130

300130

300130

Abstract: In this paper, the surface topography of GaN grown on Si substrate and V defects were investigated by atomic force microscopy (AFM). The results showed that the sample with thickness 0.5 μm has a lower roughness than other samples, and no microcracks occurred. Furthermore, there were many pits on the sample whose thickness is 0.4 μm , the density is about 10 8 cm^{-2} . The pits were V defects.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]